

# 第五章压电式传感器



## 本章主要内容

- 0 引言
- 1 压电效应和材料及机电转换
- 2 压电传感器的测量电路
- 3 传感器系统的频率响应
- 4 压电传感器的误差分析
- 5 压电传感器的应用

## 0 引言

#### 压电传感器的特点:

- ■压电式传感器是一种典型的<mark>有源传感器(或发电型</mark>传感器)。
- ■压电传感元件是力敏感元件-----能测量力、压力、加速度等。
- ■具有响应频带宽、灵敏度高、信噪比高、结构简单、 工作可靠、质量轻等优点。

#### 思考问题:

- ■何谓压电效应?
- ■压电敏感元件特点?
- ■传感器前置调理电路的特点?
- ■如何确定压电传感器的动态响应?
- ■误差产生原因及抑制措施
- ■应用

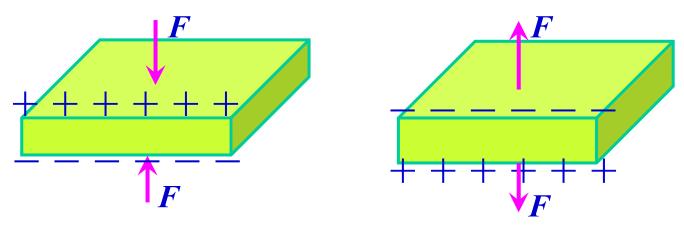
## 1 压电效应及压电材料

#### 1.1 压电效应

#### 1.1.1 定义

#### ◆ 正压电效应

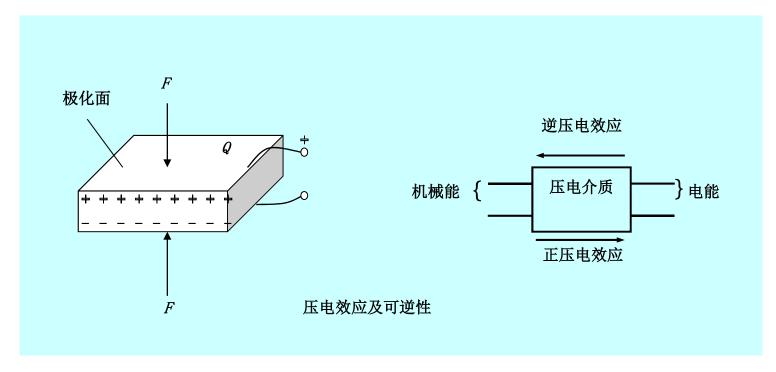
某些电介质,当沿着<u>一定方向</u>对其施力而使它变形时,内部就产生极化现象,同时在它的一定表面上产生电荷,当外力去掉后,又重新恢复不带电状态的现象。当<u>作用力</u>方向改变时,<u>电荷极性</u>也随着改变。

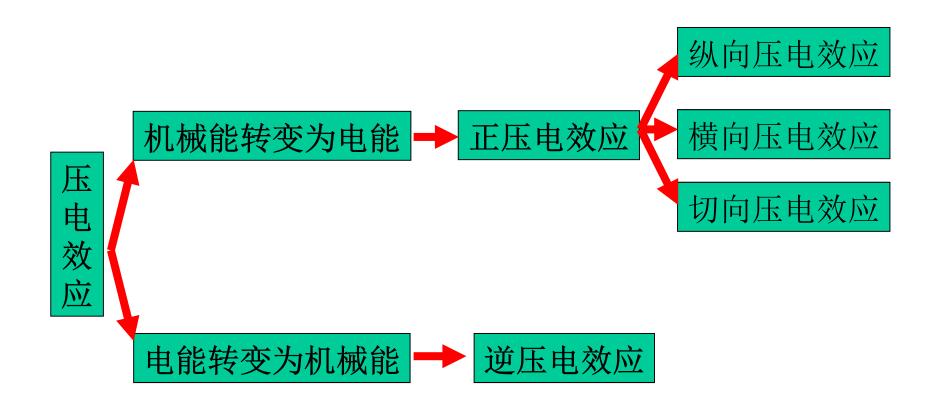


(正) 压电效应示意图

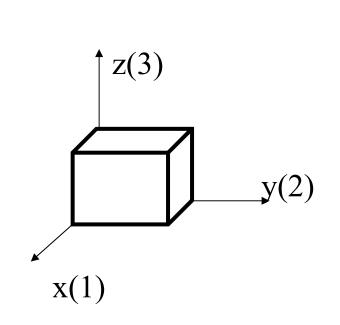
#### ◆ 逆压电效应

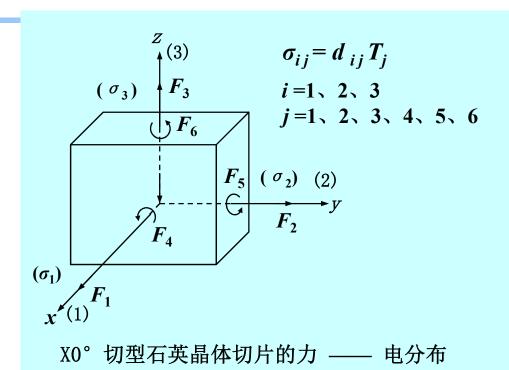
当在电介质的极化方向施加电场,某些电介质在一定方向上将产生机械变形或机械应力,当外电场撤去后,变形或应力也随之消失,这种物理现象称为逆压电效应。





## 1.1.2 压电性能参数的一般描述





❖i(i=1,2,3):表示晶体的极化方向,即在i面上产生电荷。1、2、3 分别表示垂直于x、y、z轴的晶片表面

\*j(j=1,2,3,4,5,6):1,2,3表示沿x,y,z方向作用的单向应力;4,5,6表示在yz,zx,xy平面上承受的剪切应力

## ▶压电效应的表达式:

$$\begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & d_{13} & d_{14} & d_{15} & d_{16} \\ d_{21} & d_{22} & d_{23} & d_{24} & d_{25} & d_{26} \\ d_{31} & d_{32} & d_{33} & d_{34} & d_{35} & d_{36} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \\ T_6 \end{bmatrix}$$
压电常数矩阵

$$\sigma_{i,j} = d_{i,j} \cdot T_j$$

T<sub>j:</sub> j方向的<u>应力</u>

d<sub>ij</sub>:j方向的力使得i面产生电荷的压电常数

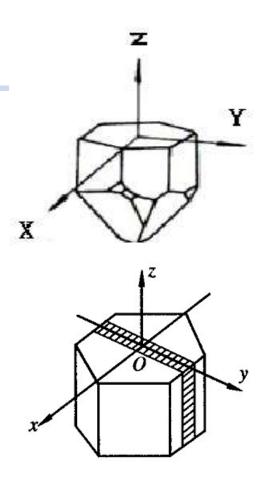
σ<sub>ii</sub>:j方向的力在i面产生的<u>电荷密度</u>

### 1.2 压电材料

- ●自然界中大多数晶体具有压电效应,但压电效应十分微弱。
- ●性能优良的压电材料(转换性能、机械性能、电性能、环境适应性、时间稳定性)
- ●实际应用的压电材料
  - (1) 压电晶体(单晶体):石英;铌酸锂等。
  - (2) 压电陶瓷: 钛酸钡; 锆钛酸铅系列(PZT系列)等。
  - (3) 压电半导体和高分子压电材料(含压电薄膜)等。

#### 1.2.1 单 (石英) 晶体材料

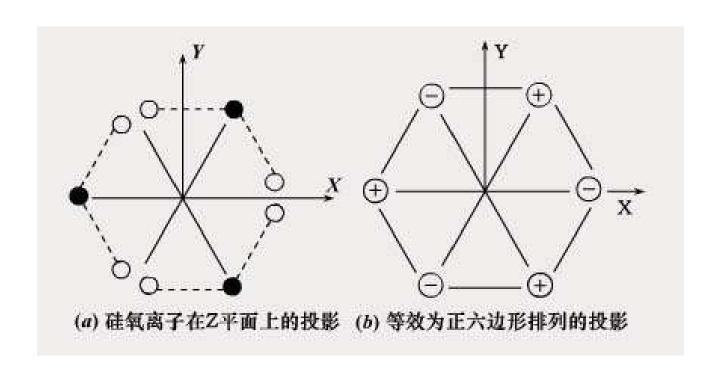
- 光学轴(基准轴, Z轴): 光沿该方向通过没有双折射现象,
- 电轴(X轴): 经过晶体棱线,垂直 于该轴的表面上压电效应最强。
- 机械轴(Y轴): 垂直xz面, 在电场作用下, 该轴方向的机械变形最明显。



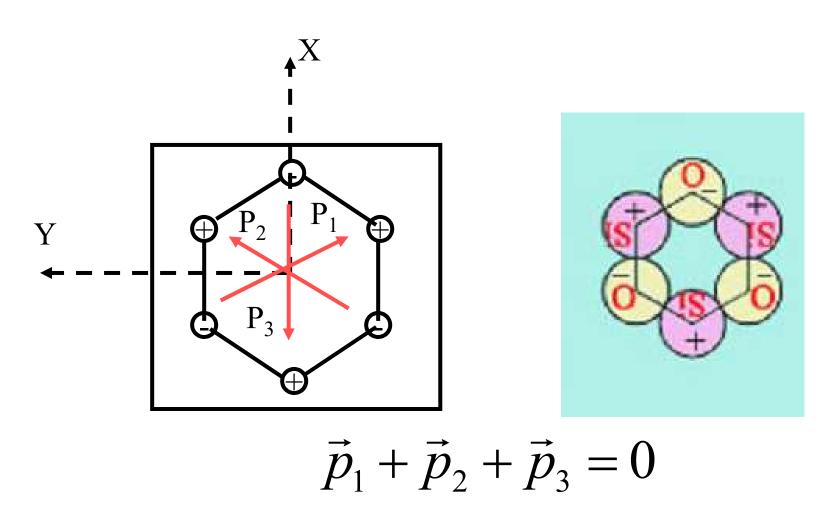




## > 石英晶体压电效应机理

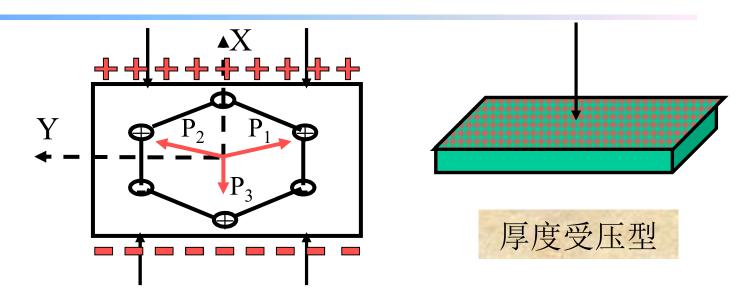


电偶极矩P=qL, q为电荷量, L为正负电荷之间距离。



当石英晶体未受外力作用时,正、负离子正好分布在正六边形的顶角上,形成三个互成120°夹角的电偶极矩 $P_1$ 、  $P_2$ 、 $P_3$ 。此时正负电荷重心重合,电偶极矩的矢量和等于零,即 $P_1+P_2+P_3=0$ ,所以晶体表面不产生电荷,即呈中性。

## 受到X方向的力—纵向压电效应



$$(\vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \vec{p}_3)_x > 0$$
 晶体沿x方向将产生压缩变形,正负离子的相对位置也随之变动。此时正负电荷重心不再重合。

$$(\vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \vec{p}_3)_y = 0$$

$$(\vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \vec{p}_3)_z = 0$$

✓电偶极矩在x方向上的分量由于 $P_3$ 的减小和 $P_1$ 、 $P_2$ 的增加而不等于零,在x轴的正方向出现正电荷,电偶极矩在y方向上的分量仍为零,不出现电荷。

✓ 当作用力方向相反时, 电荷的极性也随之改变。

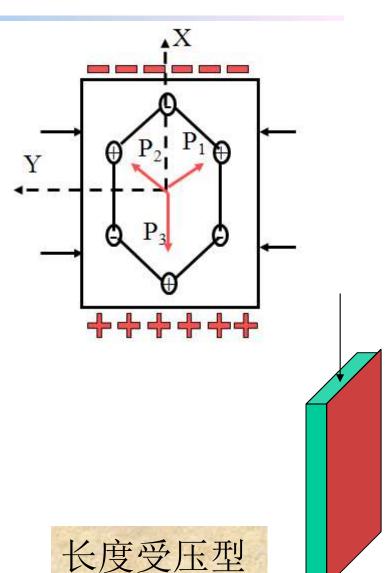
## 受到Y方向的力—横向压电效应

$$(\vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \vec{p}_3)_x < 0$$

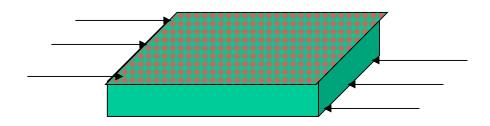
$$(\vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \vec{p}_3)_y = 0$$

$$(\vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \vec{p}_3)_z = 0$$

- ✓当晶体受到沿y轴方向的压力作用时, $P_3$ 增大, $P_1$ 、 $P_2$ 减小。
- ✓在垂直x轴表面上出现电荷,它的极性为x 轴正向为负电荷。在y轴方向上不出现电 荷。
- ✓当作用力方向相反时, 电荷的极性也随之 改变。



## 受到平面切向力—剪切压电效应



厚度切变型

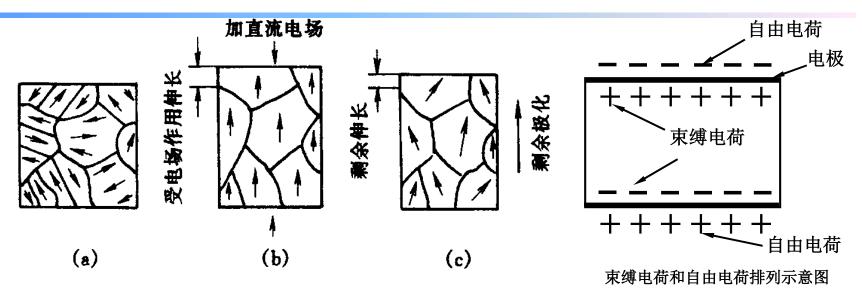
## 石英晶体压电常数矩阵:

$$\begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_{11} & -d_{11} & 0 & d_{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -d_{14} & -2d_{11} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \\ T_6 \end{bmatrix}$$

独立压电常数: 
$$d_{11} = \pm 2.31 \times 10^{-12} c/N$$
  
$$d_{14} = \pm 0.73 \times 10^{-12} c/N$$

- ① 压电系数的温度稳定性好。在20℃至200℃温度范围内,温度每升高 1℃,压电系数仅减少0.016%,当温度达到573℃时(居里点),石 英晶体丧失压电特性。
- ② 各向异性的晶体,按不同方向切割的晶片,其物理性质相差很大。

#### 1.2.2 压电陶瓷材料



BaTiO<sub>3</sub> 压电陶瓷的极化

- (a) 极化前; (b) 极化; (c) 极化后
- ●极化前,各个电畴在晶体上杂乱分布,极化效应被相互抵消,原始的压 电陶瓷内极化强度为零;
- ●在外电场作用下,电畴的极化方向趋向于按外电场的方向;
- 极化处理后,陶瓷内部仍存在有很强的剩余极化强度。
- ●受到压力后,自由电荷过剩出现放电现象。受到拉力,出现充电现象。<sub>18</sub>

## 压电陶瓷变形形式:

$$\begin{bmatrix} \sigma_{1} \\ \sigma_{2} \\ \sigma_{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & d_{15} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -d_{15} & 0 & 0 \\ d_{31} & d_{31} & d_{33} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{1} \\ T_{2} \\ T_{3} \\ T_{4} \\ T_{5} \\ T_{6} \end{bmatrix} \qquad \begin{aligned} d_{33} &= 190 \times 10^{-12} (c/N) \\ d_{31} &= d_{32} = -0.41 d_{33} \\ d_{15} &= -d_{24} = 250 \times 10^{-12} (c/N) \end{aligned}$$

- 厚度变形: d<sub>33</sub>
- 长度变形: d<sub>31</sub>、d<sub>32</sub>
- 剪切变形: d<sub>24</sub>、d<sub>15</sub>
- 体积变形: d<sub>31</sub>、d<sub>32</sub>、d<sub>33</sub>

#### 压电陶瓷外形



压电陶瓷的性能:

- ①很高的压电系数;
- ②居里点温度低;
- ③有热释电现象;
- ④稳定性不如石英晶体;
- ⑤人工制造,成本低。



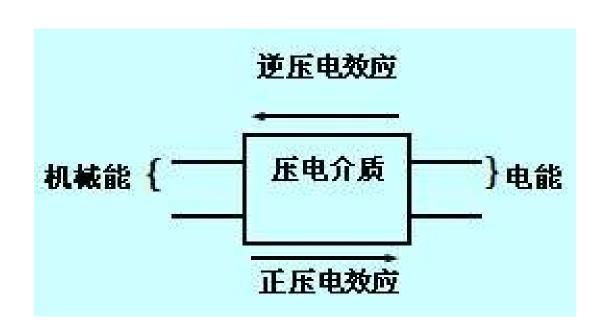
无铅压电陶瓷及其换能器外形

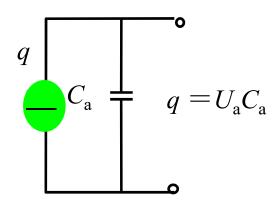
表 6-1 常用压电材料性能

压电材料 性 能	石 英	钛 酸 钡	告钛酸铅 PZT-4	锆钛酸铅 PZT-5	锆钛酸铅 PZT-8
压电系数/(pC/N)	$d_{11} = 2.31$ $d_{14} = 0.73$	$d_{15} = 260$ $d_{31} = -78$ $d_{33} = 190$	$d_{15} \approx 410$ $d_{31} = -100$ $d_{33} = 230$	$d_{15} \approx 670$ $d_{31} = -185$ $d_{33} = 600$	$d_{15} \approx 330$ $d_{31} = -90$ $d_{33} = 200$
相对介电常数/ε,	4.5	1200	1050	2100	1000
居里点温度/℃	573	115	310	260	300
密度/(10³ kg/m³)	2.65	5.5	7.45	7.5	7.45
弹性模量/(10³ N/m²)	80	110	83.3	117	123
机械品质因数	10 <sup>5</sup> ~10 <sup>6</sup>		≥500	80	≥800
最大安全应力/(10 <sup>5</sup> N/m²)	95~100	81	76	76	83
体积电阻率/Ω•m	>1012	10¹º(25℃)	>1010	10¹¹(25℃)	
最高允许温度/℃	550	80	250	<b>2</b> 50	
最高允许湿度/%	100	100	100	100	

压电晶体 | 压电陶瓷

### 1.3 压电元件的机电转换模型





$$C_a = \frac{\varepsilon S}{t} = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{t}$$

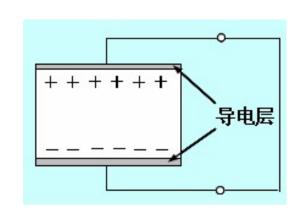
### 1.3 压电元件的机电转换模型(续)

#### 电边界为短路状态:

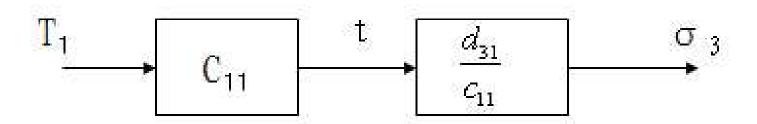
- ①应力 $T_1$ 与形变t关系为:  $t=C_{11}T_1$  式中:  $C_{11}$ 为压电陶瓷固有的柔度系数;
- ②与 $T_1$ 作用下产生的变形对应有束缚电荷  $\sigma_3$ = $d_{31}T_1$ ;

所以有: 
$$t = c_{11}T_{1}$$
;

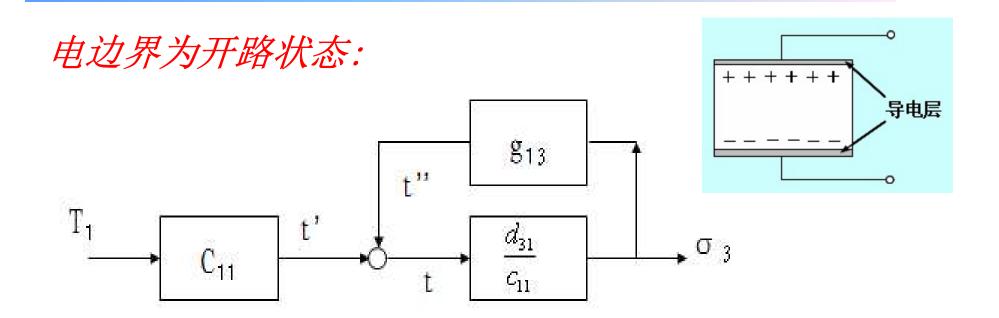
$$\sigma_3 = d_{31}T_1 = \frac{d_{31}}{c_{11}}t$$



特点:信号流是单向的。



### 1.3 压电元件的机电转换模型(续)



$$\sigma_3 = \frac{d_{31}}{1 + g_{13} \times \frac{d_{31}}{c_{11}}} T_1 = d_{ef} T_1$$

特点: 信号流有环路。

## 2 压电式传感器的测量电路

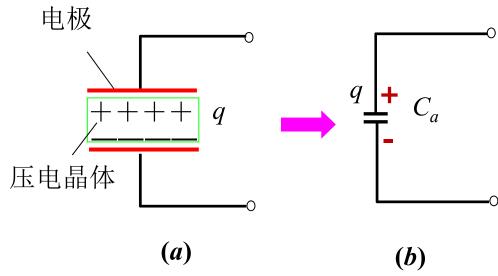
#### 2.1 传感器的等效电路

当压电传感器承受机械应力作用时,在它两极板上出现极性相反的等量电荷。因此可以把压电传感器看成一静电发生器,也可看成两极板充有电荷的电容器。

#### 其电容量为:

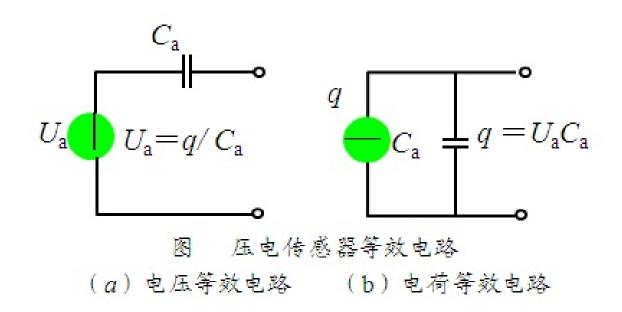
$$C_a = \frac{\varepsilon S}{t} = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{t}$$

t: 晶体厚度 (m)



压电传感器的等效电路

### 2.1 传感器的等效电路(续)



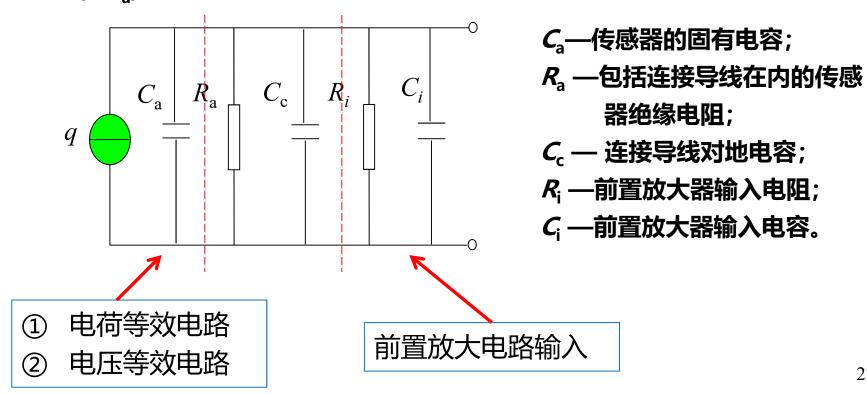
由等效电路可知,只有传感器内部信号电荷无"漏损",外电路负载为无穷大时,传感器产生的电压或电荷才能长期保存,否则电路将以某时间常数按指数规律放电。

#### ◆ 不适合于静态测量

#### 2.2 压电传感器的前置测量电路

#### ▶压电传感器的实际等效电路

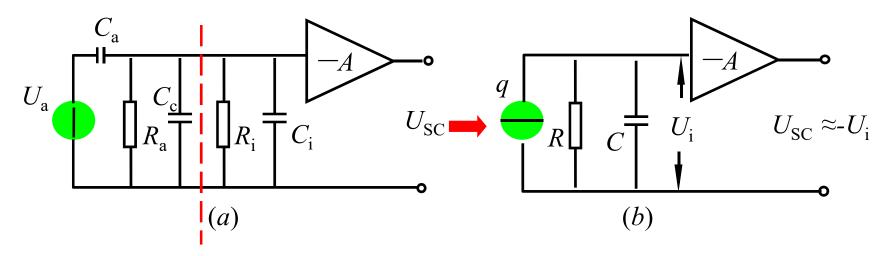
压电传感器在实际使用时总要与测量仪器或测量电路相连接, 因此还须考 虑连接电缆的等效电容Cc, 放大器的输入电Ri, 输入电容Ci以及压电传感器的泄 漏电阻R<sub>a</sub>,



### 2.2 压电传感器的前置测量电路(续)

## ▶电压放大器\_阻抗变化器

压电传感器连接电压放大器:



$$U_a = \frac{q}{C_a}$$

等效电阻R:

$$R = \frac{R_a R_i}{R_a + R_i}$$

等效电容: 
$$C = C_a + C_c + C_{i_{28}}$$

#### 设压电材料所受作用力F为

$$\dot{F} = F_m \sin \omega t$$

若压电材料为压电陶瓷,其压电系数为 $d_{33}$ ,则在外力作用下,压电元件产生的电荷值为

$$\dot{q} = d_{33}\dot{F}$$

$$q = d_{33}F_m \sin \omega t$$

#### 由图 (b) 可得送入放大器输入端的电压 Ui, 将其写为复数形式, 为

$$\dot{U}_i = j\omega q \cdot (R//\frac{1}{j\omega c})$$

$$\dot{U}_i = d_{33}\dot{F}\frac{j\omega R}{1 + j\omega RC}$$

$$m{U_{im}}$$
 =  $rac{d_{33}\omega R}{\sqrt{1+\omega^2R^2\left(C_a+C_c+C_i
ight)^2}}F_m$  =  $rac{d_{33}\omega R}{\sqrt{1+\omega^2R^2C^2}}F_m$ 

#### 令 $\tau = R(C_a + C_c + C_f) = RC$ , $\tau$ 为测量回路的时间常数,则可得

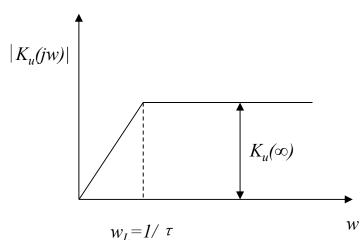
$$U_{sc} \approx U_{im} = \frac{1}{C} \cdot \frac{d_{33} F_m \omega \tau}{\sqrt{1 + (\omega \tau)^2}}$$

电压灵敏度为: 
$$|K_u(j\omega)| = \left| \frac{\dot{U}_i}{\dot{F}} \right| = \frac{d_{33}}{C} \cdot \frac{\omega \tau}{\sqrt{1 + (\omega \tau)^2}}$$

$$|K_u(j\omega)| = \left| \frac{\dot{U}_i}{\dot{F}} \right| = \frac{d_{33}}{C} \cdot \frac{\omega \tau}{\sqrt{1 + (\omega \tau)^2}}$$

#### 当ωτ<< 1 时

$$|K_u(j\omega)| \approx d_{33}\omega R$$



#### 当ωτ>>1 时

$$|K_u(j\omega)| \approx \frac{d_{33}}{C} = \frac{d_{33}}{C_a + C_c + C_i} = |K_u(j\infty)|$$

$$\omega_L = 2\pi f_L = \frac{1}{\tau}$$

$$\therefore f_L = \frac{1}{2\pi RC}$$

理想输出: 
$$U_0 = \frac{d_{33}}{C}F$$

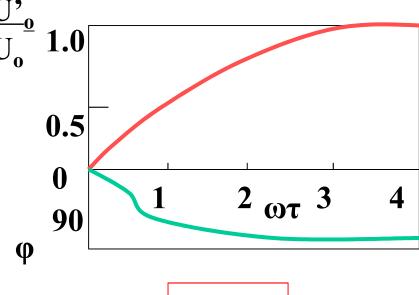
$$C = C_a + C_c + C_i$$

实际输出: 
$$U_0' = \frac{d_{33}}{C} \cdot \frac{\omega \tau}{\sqrt{1 + (\omega \tau)^2}} F$$

$$\frac{U_0'}{U_0} = \frac{\omega \tau}{\sqrt{1 + (\omega \tau)^2}} \qquad |K_u(j\omega)| \approx \frac{d_{33}}{c} = |K_u(j\infty)|$$

分析:

- (1) 当ωτ=0 (静态力) 时,
- (2) 当ωτ> 3 时 (U)/U=0.95)



改善低频响应 
$$\rightarrow \downarrow \omega_0 = \frac{1}{\tau} \rightarrow \uparrow \tau \rightarrow \begin{cases} R \uparrow \\ C \uparrow \rightarrow K_u \downarrow \end{cases}$$
  $\tau = RC$ 

R.越大,时间常数越大,则低频响应也越好。

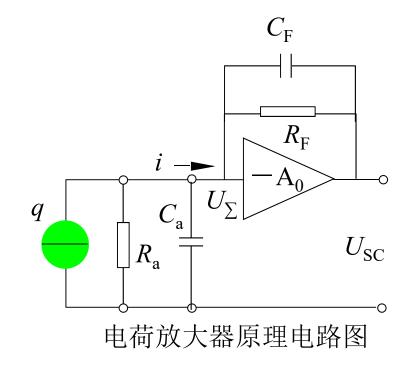
(3)  $K_{\mu}$ 受电缆分布电容的影响较大,改变电缆长度 $C_{c}$ 将改变,须重新校准灵敏度值。

### 2.2 压电传感器的前置测量电路(续)

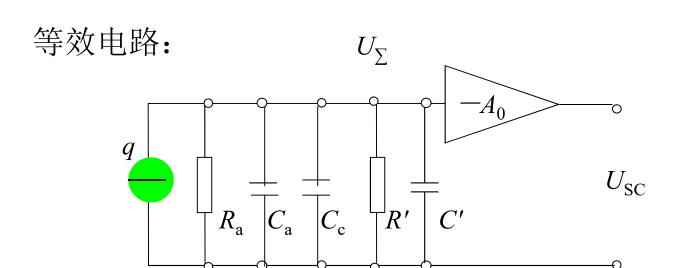
#### ▶电荷放大器

电荷放大器是一个具有深度负反馈的高增益放大器,其等效电路如图所示。 若开环增益A<sub>0</sub>足够大,并且输入阻抗很高,则放大器输入端几乎没有分流,电 流仅流入反馈回路*C<sub>E</sub>与R<sub>E</sub>*。由图可知电流/的表达式为:

$$\begin{split} \dot{i} &= (\dot{U}_{\Sigma} - \dot{U}_{SC})(j\omega C_F + \frac{1}{R_F}) \\ &= [\dot{U}_{\Sigma} - (-A_0)\dot{U}_{\Sigma}] \left(j\omega C_F + \frac{1}{R_F}\right) \\ &= \dot{U}_{\Sigma} \left[j\omega (A_0 + 1)C_F + (A_0 + 1)\frac{1}{R_F}\right] \\ &= C_F' & I/R' \end{split}$$



### 2.2 压电传感器的前置测量电路(续) ▶电荷放大器



考虑电缆电容Cc

图5-20 压电传感器接至电荷放大器的等效电路图

"密勒效应"

$$C' = (1 + A_0)C_F$$

$$R' = R_F / (1 + A_0)$$

## 2.2 压电传感器的前置测量电路(续) ▶电荷放大器

#### 运放输入电压为

$$\dot{U}_{\Sigma} = \frac{j\omega\dot{q}}{\left[\frac{1}{R_a} + \left(1 + A_0\right)\frac{1}{R_F}\right] + j\omega\left[C_a + C_c + \left(1 + A_0\right)C_F\right]}$$

#### 运放输出电压为

$$\dot{U}_{SC} = -A_0 \dot{U}_{\Sigma} = \frac{-j\omega \dot{q} A_0}{\left[\frac{1}{R_a} + (1 + A_0) \frac{1}{R_F}\right] + j\omega \left[C_a + C_c + (1 + A_0)C_F\right]}$$

#### 2.2 压电传感器的前置测量电路(续) ▶电荷放大器

当 $A_0$ 足够大时,

$$\left| \frac{\dot{U}_{SC}}{\dot{q}} \right| \approx \left| \frac{-j\omega A_0}{(1+A_0)(1/R_F + j\omega C_F)} \right|$$

$$\left| \frac{\dot{U}_{SC}}{\dot{q}} \right| \approx \left| \frac{-j\omega}{(1/R_F + j\omega C_F)} \right| = \frac{1}{C_F} \cdot \frac{\omega \tau}{\sqrt{1+(\omega \tau)^2}} \qquad \tau = R_F C_F$$

若 
$$q = d_{33}F$$
,则

$$|K(j\omega)| = \left| \frac{\dot{U}_{SC}}{\dot{F}} \right| \approx \frac{d_{33}}{C_F} \cdot \frac{\omega \tau}{\sqrt{1 + (\omega \tau)^2}}$$

#### 2.2 压电传感器的前置测量电路(续) ▶电荷放大器

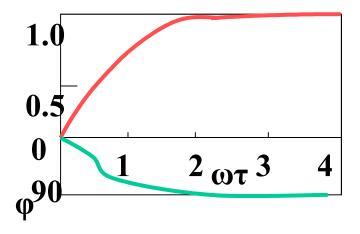
$$|K(j\omega)| = \frac{|\dot{U}_{SC}|}{\dot{F}} \approx \frac{d_{33}}{C_F} \cdot \frac{\omega \tau}{\sqrt{1 + (\omega \tau)^2}} \qquad \tau = R_F C_F$$

$$|K_u(jw)| \qquad 0.5$$

$$\omega_L = I/\tau \qquad \omega \qquad 0$$

$$f_L = \frac{\omega_L}{2\pi} = \frac{1}{2\pi R_F C_F}$$

$$\tau = R_F C_F$$



$$\alpha R_F C_F >> 1$$
 By,  $|K(j\omega)| = \left|\frac{\dot{U}_{SC}}{F}\right| \approx \frac{d_{33}}{C_F}$ 

理论值: 
$$\left|K(j\omega)\right| = \frac{d_{33}}{C_F}$$

#### 分析\_开环放大倍数A。对精度的影响

#### > 电荷放大器

$$\dot{U}_{SC} = \frac{-j\omega\dot{q}A_0}{\left[\frac{1}{R_a} + \left(1 + A_0\right)\frac{1}{R_F}\right] + j\omega\left[C_a + C_c + \left(1 + A_0\right)C_F\right]}$$

$$\therefore R_a \to \infty$$

$$\therefore \dot{U}_{SC} = \frac{-j\omega\dot{q}A_0}{\left[\left(1+A_0\right)\frac{1}{R_F}\right] + j\omega\left[C_a + C_c + \left(1+A_0\right)C_F\right]}$$

$$= \frac{-j\omega\dot{q}A_0R_F}{\left(1+A_0\right)\left[1+j\omega R_F\right]\left[\frac{C_a + C_c}{1+A_0} + C_F\right]}$$

#### 分析\_开环放大倍数A。对精度的影响

#### ▶电荷放大器

当
$$\omega R_F C_F \gg 1$$
时, $U_{SC} \approx \frac{-A_0 q}{C_a + C_c + (1 + A_0)C_F}$   $U'_{SC} \approx -\frac{q}{C_F}$ 

则误差为 
$$\delta = \frac{U'_{SC} - U_{SC}}{U'_{SC}} = \frac{C_a + C_c + C_F}{C_a + C_c + (1 + A_0)C_F}$$

若 
$$C_a = 1000 \text{pF}$$
,  $C_F = 100 \text{pF}$ ,  $C_c = (100 \text{pF/m}) \times 100 \text{m} = 10^4 \text{ pF}$ 

当要求  $\delta$ ≤1%,则有

若 
$$\delta = 0.0001 = \frac{1000 + 100 + 10000}{1000 + 10000 + (1 + A_0) \times 100}$$
 得  $A_0 \ge 10^6$ 

对线性集成运算放大器来说,这些要求是不难达到的,因此

放大倍数A。对测量精度影响通常可忽略。

## 前置电路接电荷放大器的特点:

#### **▶电荷放大器**

- ●用高增益的运算放大器形成电短路的边界条件:
- ●更换电缆无需重新校准灵敏度;
- ●灵敏度取决于已知的、固定的C<sub>F</sub>,有利于灵敏度的稳定和调整;
- ●电荷放大器时间常数相当大,可用于准静态测量。

## 3 传感器系统的频响分析

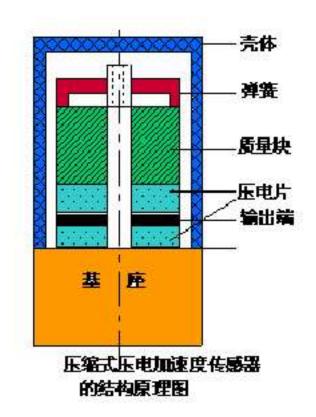
## 3.1 结构及工作原理

以纵向压缩型加速度计为例

结构:一般有纵向效应型、横向效应型和剪 切效应型三种,纵向效应型最常见。

> 压电陶瓷片和质量块为环型,通过 螺母弹簧对质量块预先加载,使之 压紧在压电陶瓷片上。测量时将传 感器基座与被测对象牢牢紧固在一 起。输出信号由电极引出。

#### 工作原理:



## 3 传感器系统的频响分析(续)

#### 3.2 灵敏度

质量块感受的惯性力 F = ma

$$q = d_{33}F = d_{33}ma$$

接受的惯性力 
$$F=ma$$
 
$$\begin{cases} k_u = \frac{u_a}{a} = \frac{d_{33}m}{c_a} \\ k_q = \frac{q}{a} = d_{33}m \end{cases}$$

$$k_q = \frac{q}{a} = d_{33}m$$

#### 分析:

- (1) 为了提高传感器的灵敏度,一般选择压电系数大的压电陶瓷片。
- (2) 灵敏度虽然正比于质量块的质量,但会影响被测振动,同时会 降低振动系统的固有频率,因此一般不用增加质量的方法来提高传感 器灵敏度。

# 3 传感器系统的频响分析(续) 3.2 灵敏度

根据被测对象及测量 要求选择不同质量的传感 器。

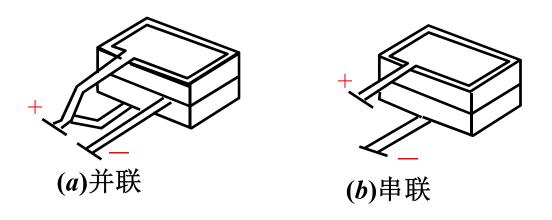
质量范围: 0.x g~ x kg



## 3 传感器系统的频响分析(续) 3.2 灵敏度

#### (3) 增加压电片数目来提高灵敏度

连接方式: 并联形式和串联形式



叠层式压电元件的串联和并联图

## 3 传感器系统的频响分析(续) 3.2 灵敏度

# 并联形式: $q' = 2q, U' = U_a, C' = 2C_a \longrightarrow \begin{cases} k_u' = \frac{u'}{a} = k_u \\ k_q' = \frac{q'}{a} = 2k_q \end{cases}$

#### 串联形式:

$$q' = q, \ U' = 2U_a, \ C' = \frac{1}{2}C_a \longrightarrow \begin{cases} k_u ' = \frac{u'}{a} = 2k_u \\ k_q ' = \frac{q'}{a} = k_q \end{cases}$$

- ▶并联接法 输出电荷大,时间常数大,宜用于测量缓变信号,并且适用于以电荷为输出量的场合。
- ▶ 串联接法 输出电压大,本身电容小,适用于以电压作为输出信号,且测量电路输入阻抗很高的场合。

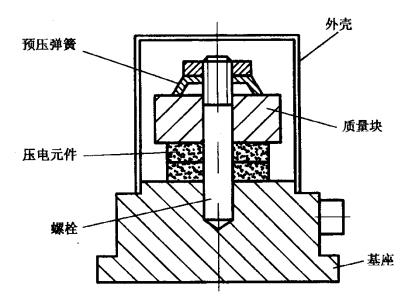
## 3 传感器系统的频响分析(续)

#### 3.3 系统响应 (动态响应)



- •测量线路的频率响应决定系统的低频性能;
- •系统的高频部分受到力学系统的固有频率限制;
- •压电元件的性能则对系统的灵敏度起重要作用。

#### (1) 力学系统:



压电式加速度传感器结构图

$$m\frac{d^2x_m}{dt^2} = -c\frac{dx_i}{dt} - kx_i$$

则

$$m\frac{d^{2}x_{m}}{dt^{2}} = -c\frac{d(x_{m} - x_{0})}{dt} - k(x_{m} - x_{0})$$

#### 3.3 系统响应 (动态响应)

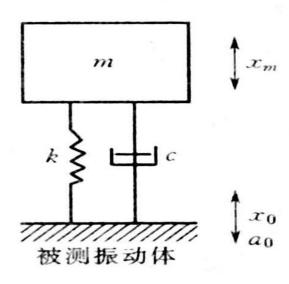


图5-23 二阶系统模拟

设被测振动体位移 $x_0$ ,质量块相对位移 $x_m$ ,则质量块与被测振动体的相对位移为 $x_i$ ,即

$$x_i = x_m - x_0$$

#### 将上式改写为

#### 3.3 系统响应 (动态响应)

$$\frac{d^{2}(x_{m}-x_{0})}{dt^{2}} + \frac{c}{m}\frac{d(x_{m}-x_{0})}{dt} + \frac{k}{m}(x_{m}-x_{0}) = -\frac{d^{2}x_{0}}{dt^{2}}$$

设加速度  $a_0 = \frac{d^2 x_0}{dt^2}$ ,输出为 $(x_m - x_0)$ ,并引入算子  $D = \frac{d}{dt}$ ,则

$$\frac{x_m - x_0}{a_0} = \frac{-1}{D^2 + 2\xi\omega_0 D + \omega_0^2}$$

式中  $\xi$ ——相对阻尼系数,  $\xi = \frac{c}{2\sqrt{km}}$   $\omega_0$ ——固有频率, $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ 

将上式写为频率传递函数,则有

$$\frac{x_m - x_0}{a_0}(j\omega) = \frac{-(1/\omega_0)^2}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + 2\xi\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)j}$$

#### 其幅频特性为

#### 3.3 系统响应 (动态响应)

$$\left| \frac{x_m - x_0}{a_0} (j\omega) \right| = \frac{(1/\omega_0)^2}{\sqrt{\left[ 1 - \left( \frac{\omega}{\omega_0} \right)^2 \right]^2 + \left[ 2\xi \left( \frac{\omega}{\omega_0} \right) \right]^2}} \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$= \left| \frac{S}{a_0} (j\omega) \right|$$

#### 相频特性

$$\varphi(\omega) = -\arctan\frac{2\xi\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2} - 180^\circ$$

#### 3.3 系统响应 (动态响应)

## (2) 压电元件

由于质量块与被测振动体相对位移s,也就是压电元件 受力后产生的变形量,于是压电元件所受力为

$$F = k \cdot s$$
  $k$ ——压电元件弹性系数

则产生的电荷为:

$$q = d_{33}F = d_{33}ks$$

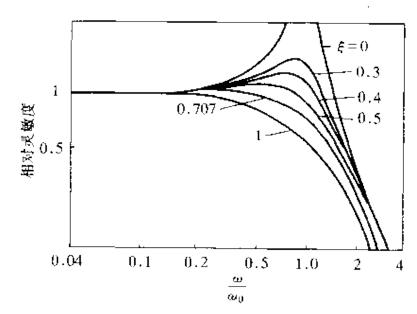
#### 3.3 系统响应 (动态响应)

#### 则压电元件与力学系统的动态特性为:

$$\frac{q}{a} = \frac{d_{33}k/\omega_0^2}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right]^2 + \left[2\xi\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)\right]^2}}$$

$$\omega << \omega_0$$
时,

$$\frac{q}{a} \approx \frac{d_{33}k}{\omega_0^2}$$



加速度传感器的频响特性

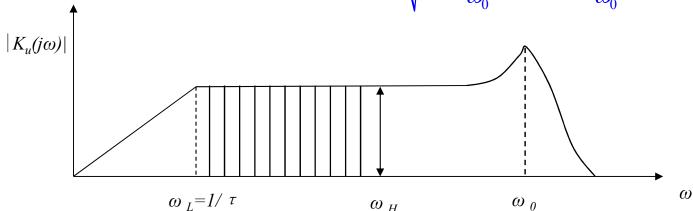
#### 3.3 系统响应 (动态响应)

#### (3) 系统输出电压和加速度的关系

系统的幅频特性 
$$|\Phi(j\omega)| = \left|\frac{S(j\omega)}{a(j\omega)}\right| \cdot \left|\frac{Q(j\omega)}{S(j\omega)}\right| \cdot \left|\frac{U_0(j\omega)}{Q(j\omega)}\right| = \left|\frac{U_0(j\omega)}{a(j\omega)}\right|$$

$$= \frac{1}{\omega_0^2 \sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right]^2 + 4\xi^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}} kd_{33} \frac{\omega \tau}{C\sqrt{1 + (\omega \tau)^2}}$$

以
$$\omega_0^2 = k/m$$
代入上式得:  $|\Phi(j\omega)| = \frac{d_{33}m}{C_f} \frac{1}{\sqrt{[1-(\frac{\omega}{\omega_0})^2]^2 + 4\xi^2(\frac{\omega}{\omega_0})^2}} \frac{\omega\tau}{\sqrt{1+(\omega\tau)^2}}$ 



## 4 压电式传感器的误差分析

#### 4.1 频率响应误差

$$|\Phi(j\omega)| = \frac{d_{33}m}{C_f} \frac{1}{\sqrt{[1 - (\frac{\omega}{\omega_0})^2]^2 + 4\xi^2 (\frac{\omega}{\omega_0})^2}} \frac{\omega\tau}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}$$

理想条件下:

$$|\Phi(j\omega)| = \frac{|u_o|}{|a|} = \frac{d_{33}m}{C_f}$$
  $u_o = \frac{d_{33}m}{C_f}a$ 

## 4.1 频率响应误差(续)

低频: 
$$u_o' = \frac{d_{33}m}{C_f} \frac{\omega \tau}{\sqrt{1 + (\omega \tau)^2}} a$$

$$\delta_L = \frac{\left| u_o - u_o' \right|}{u_o} = \left| 1 - \frac{\omega \tau}{\sqrt{1 + (\omega \tau)^2}} \right|$$

$$(\approx \frac{1}{2(\omega \tau)^2})$$

**高频:** 
$$\delta_{H} = \left| \frac{u_{0} - u_{0}'}{u_{o}} \right| = \left| 1 - \frac{1}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_{0}}\right)^{2}\right]^{2} + 4\xi^{2} \left(\frac{\omega}{\omega_{0}}\right)^{2}}} \right|$$

#### 4.2 温度的影响

外界温度变化将影响压电传感器的灵敏度。

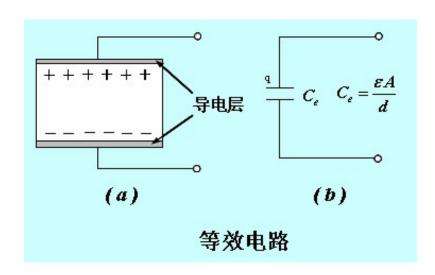
● 压电系数、等效电容量发生变化;

● 缓变温度的影响: 热释电效应(压电陶瓷), 影响低频测量

● 瞬变温度的影响:导致传感器中晶体元件受力状态的变化,

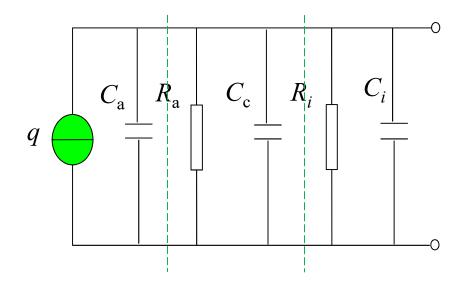
需补偿。

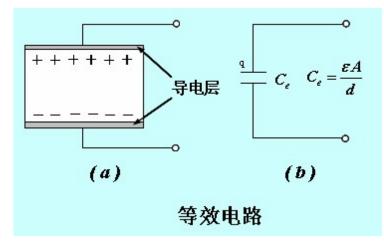
(爆炸冲击波测量)



## 4.3 环境湿度的影响

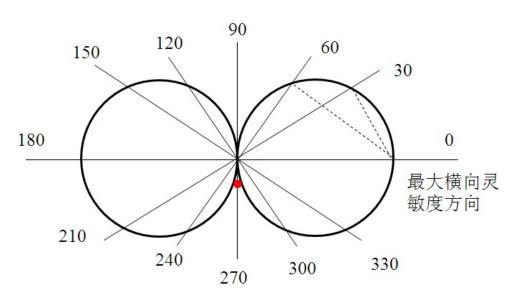
#### 外界湿度变化将影响压电传感器的绝缘电阻。



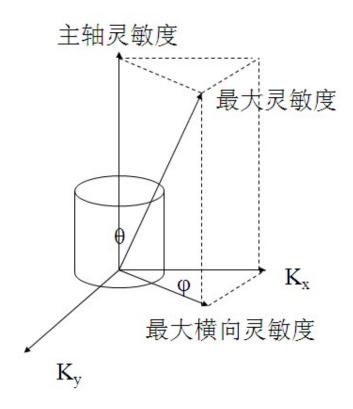


## 4.4 横向灵敏度

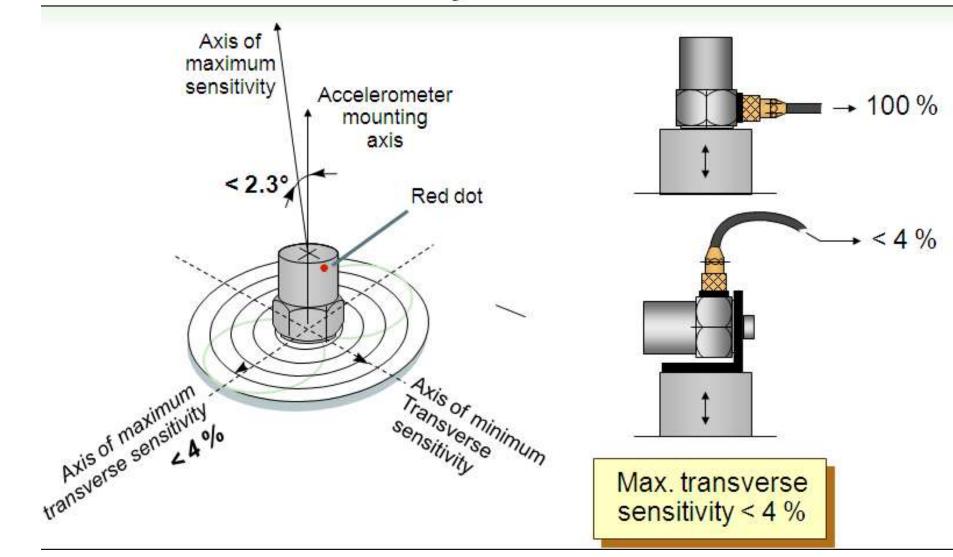
传感器最大灵敏度方向与主轴不重合。



横向灵敏度与加速度方向的关系图



#### **Transverse Sensitivity**



#### 4.5 电缆及器件噪声

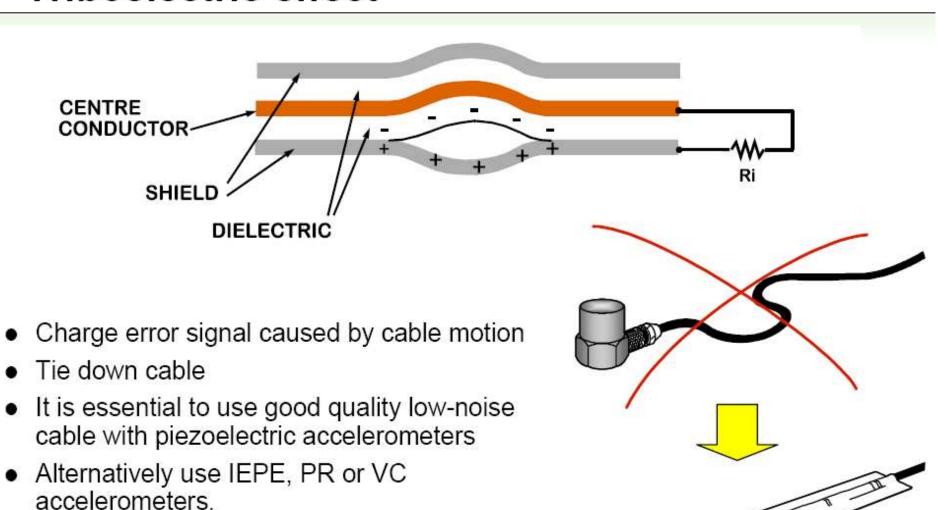
#### 问题:

- ●压电传感器的内阻很大→任何微小的干扰→产生较大的误差
- ◆为屏蔽掉外部干扰→采用屏蔽电缆
- ●传感器电缆承受机械振动和弯曲变形→屏蔽层与绝缘层分离
- ●摩擦生电→分离部分的内表面上将产生电荷
- ●感生电荷叠加在压电元件输出的电荷上→形成噪声电荷输出

解决办法1: icp (integrated circuits piezoelectric) 传感器解决办法2:

- ●将屏蔽线固定;
- ●采用特制低噪声同轴射频电缆。这种电缆的内绝缘层和屏蔽层之间涂有减摩 材料硅油和导电石墨层,它可以有效地防止电缆振动和弯曲而产生的摩擦生 电效应,从而减少电缆噪声。

#### Triboelectric effect

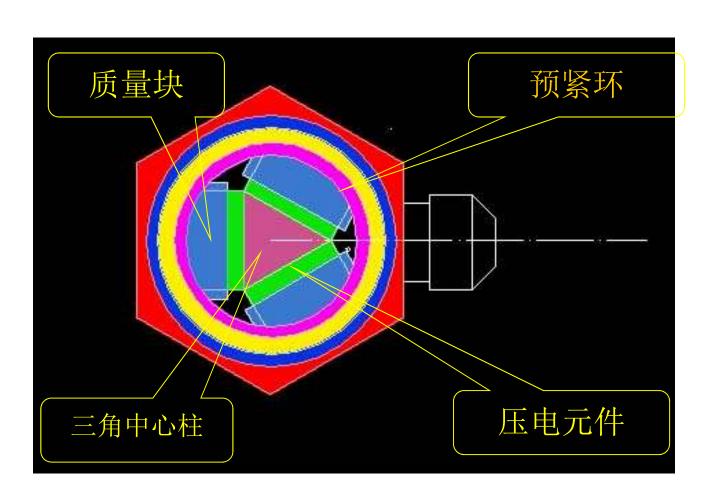


# 5 压电式传感器的应用

## 5.1 压电式加速度传感器\_结构与工作原理

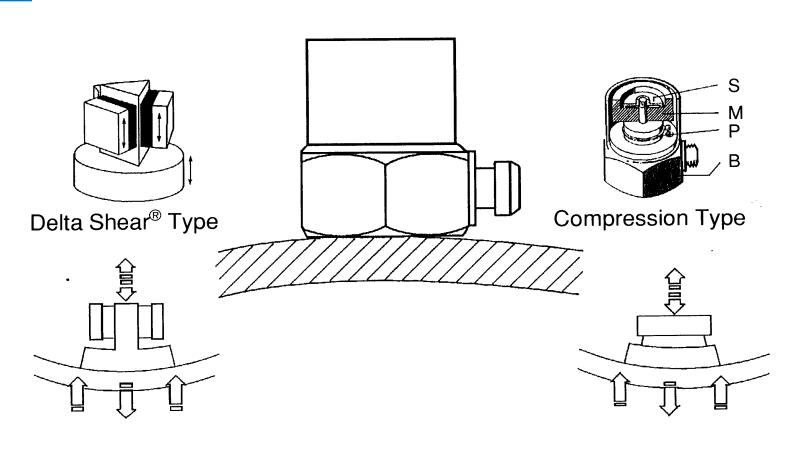
- (1) 压缩型
- (2) 剪切型

三角剪切型



## 5.1 压电式加速度传感器\_\_结构与工作原理(续)

结构特点与分析



三角剪切型

压缩型

## 5.2 压电式压力传感器

图5-25是压电式测压传感器的原理简图。它由引线1、壳体2、基座3、压电晶体4、受压膜片5及导电片6组成。

当膜片5受到压力P作用后,在一片压电 元件上产生的电荷q为

$$q = d_{11}F = d_{11}SP$$

式中 *F*——作用于压电片上的力;

d<sub>11</sub>——压电系数;

$$P$$
——压强, $P = \frac{F}{S}$ ;

S---膜片的有效面积。

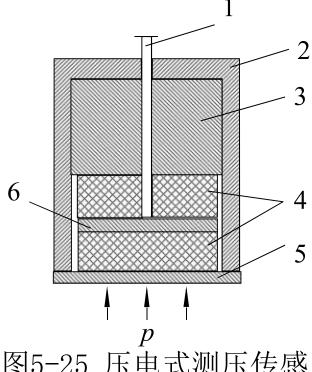


图5-25 压电式测压传感器原理图

# 5.3 激光焊接质量监测





## 5.4 玻璃打碎报警装置

#### 玻璃打碎报警装置①

将高分子压电测振薄膜粘贴在玻璃上,可以感受到玻璃破碎时会发出的振动,并将电压信号传送给集中报警系统。

问题:

灵敏度调节问题。

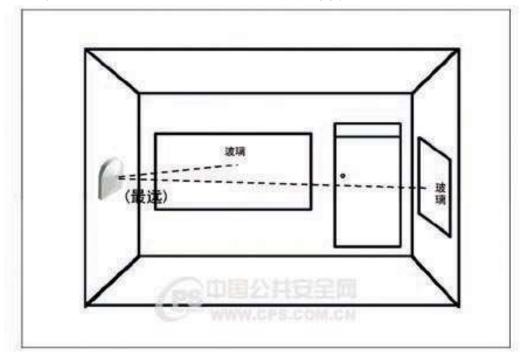


## 玻璃打碎报警装置 (续)

#### ②改进--基于破碎声音测量的玻璃破碎传感器

#### 原理:

- ●破碎时发出的响亮刺耳的声音频率:处于大约10~15kHz的高频段。
- ●带通放大器的带宽选在 10~15KHz的范围内,取出 玻璃破碎所产生高频声音。
- ●优点:对人的脚步声、 说话声、雷雨声等具有
- 较强的抑制作用,以降低误报率。
- ●另一类是双技术玻璃破碎探测器,其中包括声控-震动型和次声波-玻璃破碎高频声响型。



## 玻璃打碎报警装置 (续)

#### ③次声波—玻璃破碎高频声响双技术玻璃破碎探测器

●次声波: 频率低于20Hz的声波,属于不可闻声波。

●发生时刻:

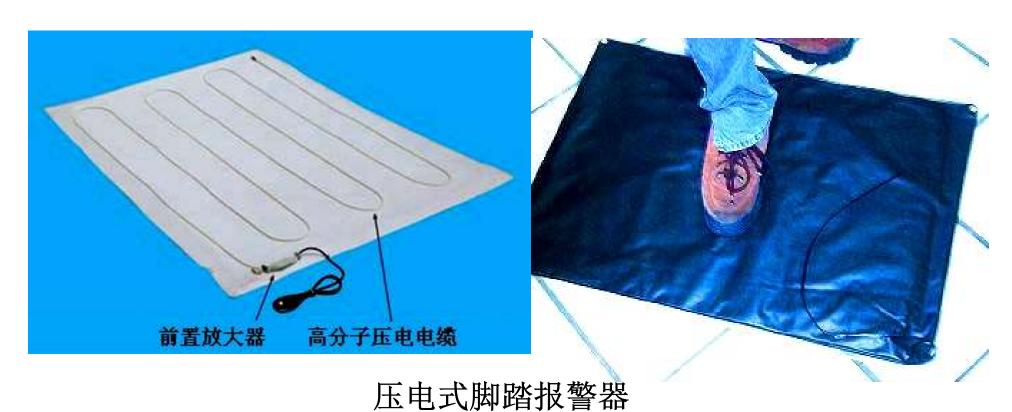
A: 玻璃破碎前, 会产生一个属于次声波超低频的弹性振动波。当玻璃破碎时, 才会发出一高频的声音。

B: 人侵者进室时,必打开一个通道。由于室内外环境不同所造成的气压、气流差,会产生超低频的次声波,其频率甚至可低于10Hz以下。

●当入侵者在打碎玻璃强行人室作案的瞬间,不仅会产生玻璃破碎时的可闻声波和相关物体(如窗框、墙壁等)的振动,还会产生次声波,并在短时间充满室内空间。

## 5.5 压电踏脚板

- ●根据需要制成薄膜或电缆套管等形状。
- ●不易破碎,具有防水性,可以制成较大面积或较长的尺度。



## 5.6 其它

水听器、传声器

## 作业:

6-1,6-3(简答)

6-6, 6-7, 6-8

下周二交作业